

Silicon Diode

BY228

1500V / 3A

DATASHEET

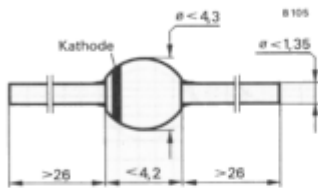
OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BY 228**Silizium-Mesa-Diode****Anwendung:** Hochspannungsgleichrichter**Besondere Merkmale:**

● Glaspassivierte Sperrschicht

● Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mmSinterglasgehäuse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g**Bestempfung Klartext****Absolute Grenzdaten**

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung	$U_{R'}$ U_{RWM}	1500	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10$ ms	I_{FSM}	50	A
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	3	A
Sperrschichttemperatur	T_j	140	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65... + 175	°C

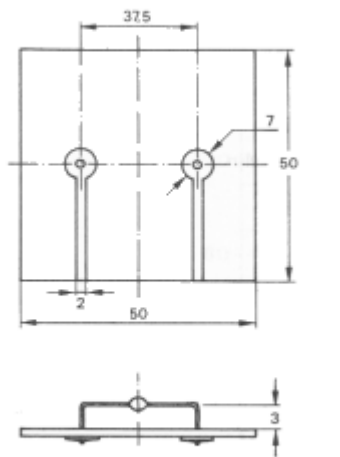
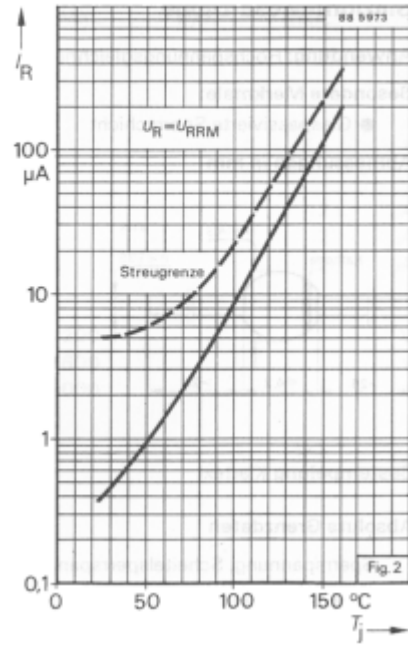
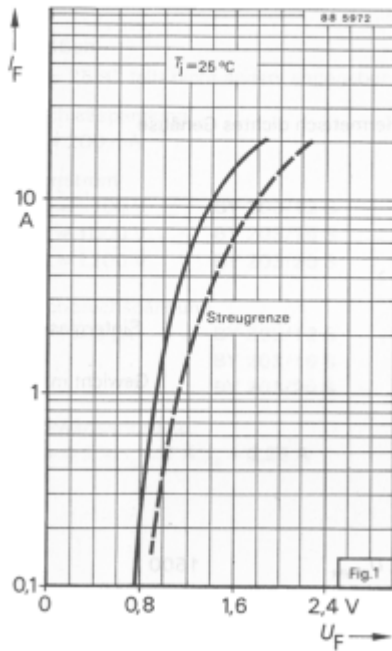
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	R_{thJA}	70	K/W
---	------------	----	-----

Kenngößen $T_j = 25$ °C, falls nicht anders angegeben

	Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung $I_F = 5$ A			1,5	V
Sperrstrom $U_R = 1500$ V		2	5	μ A
$T_j = 140$ °C, $U_R = 1500$ V			140	μ A
Gesamte Rückwärtserholzeit $I_F = 1$ A, $\frac{-d_i}{d_t} = 0,05$ A/ μ s			20	μ s

BY 228



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 70 \text{ K/W}$

Fig.3

88 5974

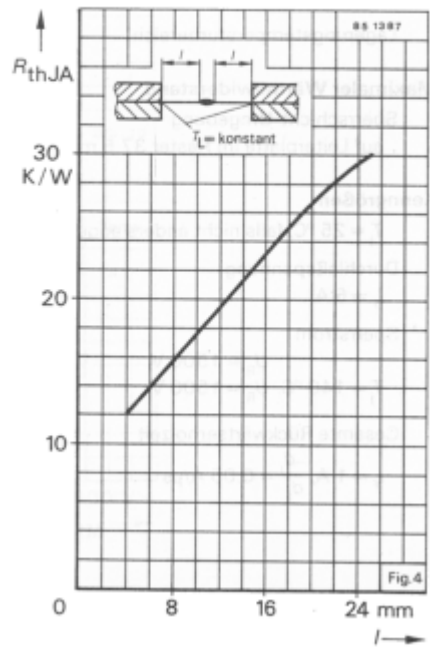


Fig.4